



产品特点

高精度MEMS工艺制备
高性能，低温漂，小体积
陶瓷基板，50Ω共面波导
金丝键合，适用于多芯片集成模块

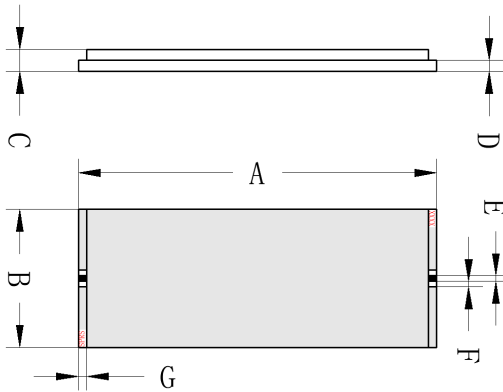
技术要求

项目	参数	单位
中心频率	8.3	GHz
工作带宽	8.0-8.6	GHz
中心损耗	3.0	dB
带内波动	1.0	dB
驻波比	1.5:1	
群时延波动	0.8	ns
带外抑制	40@DC-7.35GHz	dBc
带外抑制	40@9.3-20.0GHz	dBc

其它要求：设计保证

承受功率	<4W CW
工作温度	-55~+85°C
储存温度	-55~+125°C
外形尺寸	A:8.5, B:3.6, C:0.8, D:0.4, E:0.2, F:0.14, G:0.69

外形图：端口居中



推荐装配图

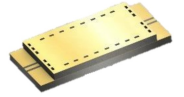


电路板Rogers5880, h: 0.254mm 适用频率: 10~40GHz	电路板Rogers5880, h: 0.127mm 适用频率: 10~70GHz

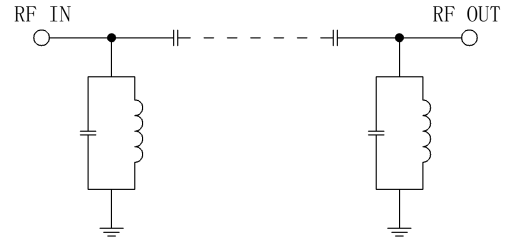
注意事项

- 1: 芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.2mm,端口可互换;
- 2: 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接,采用不少于2根25-50um金丝键合线连接,连接线尽量短,键合高度尽量低;
- 3: 芯片应安装在可伐(推荐)或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料,载体厚度≥0.2mm,,不能直接烧焊在铝或铜盒子上;
- 4: 微带线与芯片键合连接时,建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

参考实物图



原理图



典型曲线

